製品カタログ

受動RFネットワーク／インピーダンス部品

RF負荷、終端器、整合・等化ネットワークを、周波数、基準面、反射、電力、温度、使用環境で選定するための技術カテゴリです。

製品: 11

改訂: 6 · 改訂日: 2026-11-11



RF抵抗器



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

抵抗値: 15 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.35 A (標準値); 最大許容電流: 0.8 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.

抵抗素子数: 値: 1

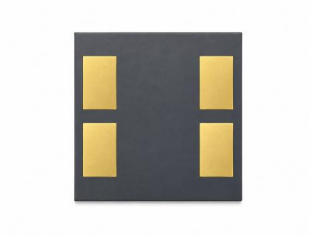
端子数: 値: 2

抵抗値: 代表値: 15; 単位: Ω

抵抗値許容差: 代表値: ±5; 単位: %

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

抵抗値: 20 / 20 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.165 / 0.165 A (標準値); 最大許容電流: 0.33 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.

抵抗素子数: 値: 2

端子数: 値: 4

抵抗値: 代表値: 20 / 20; 単位: Ω

抵抗値許容差: 代表値: ±5; 単位: %

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

抵抗値: 50 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.2 A (標準値); 最大許容電流: 0.6 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.

抵抗素子数: 値: 1

端子数: 値: 2

抵抗値: 代表値: 50; 単位: Ω

抵抗値許容差: 代表値: ±5; 単位: %

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

抵抗値: 1000 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.04 A (標準値); 最大許容電流: 0.08 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.

抵抗素子数: 値: 1

端子数: 値: 2

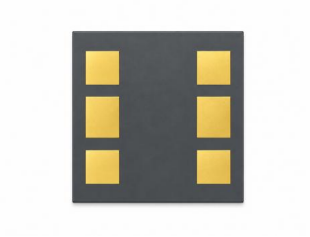
抵抗値: 代表値: 1000; 単位: Ω

抵抗値許容差: 代表値: ±5; 単位: %

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート

RFコンデンサ



LCCAP-C10PF

10 pF GaAsコンデンサベアダイ

静電容量: 10 pF (標準値); 耐電圧: 50 V (標準値). ダイ寸法: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

静電容量: 代表値: 10; 単位: pF; TA = +25 °C

耐電圧: 代表値: 50; 単位: V; TA = +25 °C

絶縁破壊電圧: 値: 80 (Vb); 単位: V

保存温度: 最小値: -65; 最大値: 150; 単位: °C

製品詳細　製品データシート

RFイコライザ



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz GaAsスロープイコライザベアダイ

イコライズ量: 2 dB; 挿入損失 @ 8000 MHz: 2.6 dB; 挿入損失 @ 12000 MHz: 0.7 dB. ダイ寸法: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

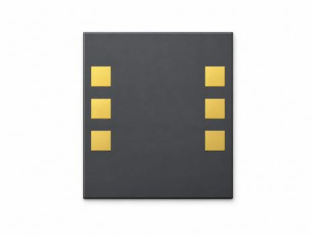
動作周波数: 最小値: 8000; 最大値: 12000; 値: 8000–12000; 単位: MHz

イコライズ量: 値: 2; 単位: dB

挿入損失 @ 8000 MHz: 値: 2.6; 単位: dB

挿入損失 @ 12000 MHz: 値: 0.7; 単位: dB

製品詳細　製品データシート



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz GaAsスロープイコライザベアダイ

イコライズ量: 5.5 dB; 挿入損失 @ 2000 MHz: 0.6 dB; 挿入損失 @ 6000 MHz: 6.1 dB. ダイ寸法: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

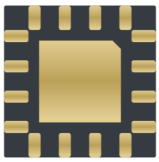
動作周波数: 最小値: 2000; 最大値: 6000; 値: 2000–6000; 単位: MHz

イコライズ量: 値: 5.5; 単位: dB

挿入損失 @ 2000 MHz: 値: 0.6; 単位: dB

挿入損失 @ 6000 MHz: 値: 6.1; 単位: dB

製品詳細　製品データシート



LCEQ-8000-12000-C

8000–12000 MHz パッケージ型 RF イコライザ — ΔIL 2 dB; IL -3.1 → -1.1 dB (標準値)

8000–12000 MHz; 等化量 2 dB (標準値); 帯域下端の挿入損失 -3.1 dB (標準値) @ 8000 MHz; 帯域上端の挿入損失 -1.1 dB (標準値) @ 12000 MHz.

動作周波数: 記号: f; 最小値: 8000; 最大値: 12000; 値: 8000–12000; 単位: MHz

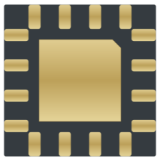
帯域下端の挿入損失: 代表値: -3.1; 値: f = 8000 MHz; 単位: dB

帯域上端の挿入損失: 代表値: -1.1; 値: f = 12000 MHz; 単位: dB

等化量: 代表値: 2; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCEQ-2000-6000-C

2000–6000 MHz パッケージ型 RF イコライザ — ΔIL 5.5 dB; IL -1 → -6.5 dB (標準値)

2000–6000 MHz; 等化量 5.5 dB (標準値); 帯域下端の挿入損失 -1 dB (標準値) @ 2000 MHz; 帯域上端の挿入損失 -6.5 dB (標準値) @ 6000 MHz.

動作周波数: 記号: f; 最小値: 2000; 最大値: 6000; 値: 2000–6000; 単位: MHz

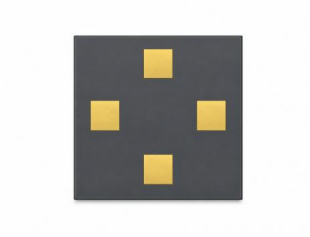
帯域下端の挿入損失: 代表値: -1; 値: f = 2000 MHz; 単位: dB

帯域上端の挿入損失: 代表値: -6.5; 値: f = 6000 MHz; 単位: dB

等化量: 代表値: 5.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz GaAs RFクロスオーバーベアダイ

挿入損失: 0.4 dB (標準値); アイソレーション: 30 dB (標準値); リターンロス: 20 dB (標準値). ダイ寸法: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 40000; 値: DC–40000; 単位: MHz

挿入損失: 代表値: 0.4; 単位: dB

アイソレーション: 代表値: 30; 単位: dB

リターンロス: 代表値: 20; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート

RFロードとダミーロード



LCLOAD-6000-25

DC–6 GHz 25 W RF終端負荷

DC–6 GHzに対応する50 ΩのRF終端負荷。CW電力容量は標準25 W、最小20 Wで、VSWRは標準1.3:1です。

動作周波数: 最小値: DC; 最大値: 6000; 単位: MHz

CW RF電力容量: 最小値: 20; 代表値: 25; 単位: W

VSWR: 代表値: 1.3:1

インピーダンス: 代表値: 50; 単位: Ω

25 °C、50 Ω

製品詳細　製品データシート

文書に関する注意
仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確

認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。